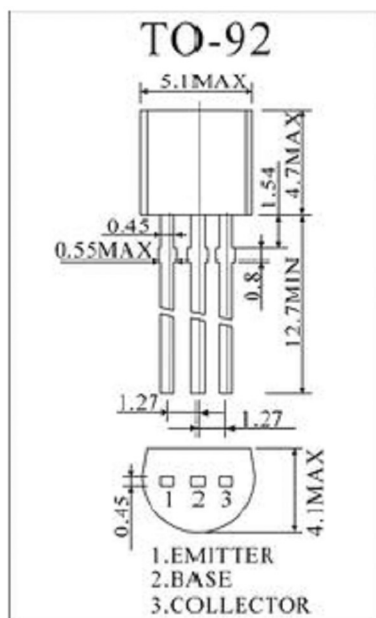


TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors 8550

绝对最大额定值 (Ta=25°C)

项 目	符 号	额 定 值	单 位
集电极—基极电压	V _{CB0}	-40	V
集电极—发射极电压	V _{CEO}	-25	V
发射极—基极电压	V _{EB0}	-6	V
集电极电流	I _c	-1.5	A
集电极耗散功率	P _c	1	W
结 温	T _j	150	°C
存储温度	T _{stg}	- 55~150	°C


电参数 (Ta=25°C)

项 目	符 号	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
直流电流增益	h _{FE}	85		300		V _{CE} = -1 V, I _c = -100 mA
集电极-基极截止电流	I _{CB0}			-0.1	μ A	V _{CB} = -35 V, I _E =0
发射极-基极截止电流	I _{EB0}			-0.1	μ A	V _{EB} = -6 V, I _c =0
集电极-基极击穿电压	BV _{CB0}	-40			V	I _c = -0.1 mA, I _E =0
集电极-发射极击穿电压	BV _{CEO}	-25			V	I _c = -2 mA, I _B =0
发射极-基极击穿电压	BV _{EB0}	-6			V	I _B = -0.1 mA, I _c =0
基极-发射极电压	V _{BE}			-1.0	V	V _{CE} = -1 V, I _c = -10 mA
集电极-发射极饱和压降	V _{CE(sat)}		-0.28	-0.5	V	I _c = -800 mA, I _B = -80 mA
基极-发射极饱和压降	V _{BE(sat)}		-0.96	-1.2	V	I _c = -800 mA, I _B = -80 mA
电流增益-带宽乘积	f _r	100			MHz	I _c = -50 mA, V _{CE} = -10 V
共基极输出电容	C _{ob}		15	30	PF	V _{CB} = -10 V, I _E =0, f= 1 MHz

h_{FE} 分档及其标志

分 档	B	C	D
h _{FE}	85~160	120~200	160~300